

КТ814

р-п-р кремниевый
биполярный транзистор

Назначение

Кремниевые эпитаксиально-планарные биполярные транзисторы. Предназначены для использования в ключевых и линейных схемах, блоках и узлах радиоэлектронной аппаратуры широкого применения.

Зарубежные прототипы

- Прототип КТ814Б - BD136
- Прототип КТ814В - BD138
- Прототип КТ814Г - BD140

Особенности

- Диапазон рабочих температур корпуса от - 60 до + 125° С
- Комплиментарная пара – КТ815



Обозначение технических условий

- аАО. 336.184 ТУ / 02

Корпусное исполнение

- пластмассовый корпус КТ-27 (ТО-126) – КТ814А, Б, В, Г
- пластмассовый корпус КТ-89 (DPAK) - КТ814А9, Б9, В9, Г9



Назначение выводов

Вывод (корпус КТ-27)	Назначение (корпус КТ-27)	Вывод (корпус КТ-89)	Назначение (корпус КТ-89)
№1	Эмиттер	№1	База
№2	Коллектор	№2	Коллектор
№3	База	№3	Эмиттер

Таблица 1. Основные электрические параметры КТ814 при $T_{\text{окр. среды}} = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Граничное напряжение колл-эмит КТ814А, А9 КТ814Б, Б9 КТ814В, В9 КТ814Г, Г9	Uкэо гр.	В	Iэ=50mA, ti=0,3 - 1 мс	30 45 65 85	
Обратный ток коллектора КТ814А, А9, Б, Б9 КТ814В, В9, Г, Г9	Iкбо	мкА	Uкэ=50 В Uкэ=65 В		50 50
Обратный ток коллектор-эмиттер КТ814А, А9, Б, Б9 КТ814В, В9, Г, Г9	Iкэг	мкА	Uкэ=50 В, Rбэ≤100 Ом Uкэ=65 В, Rбэ≤100 Ом		100 100
Статический коэффициент передачи тока КТ814А, А9, Б, Б9, В, В9 КТ814Г, Г9	h _{21э}		Uкб=2 В, Iэ=0,15А	40 30	275 275
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ нас	В	Iк=0,5 А, Iб=50 мА		0,6

Таблица 2. Предельно допустимые электрические режимы КТ814

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение
Напряжение коллектор-эмиттер (Rэб≤100Ом) КТ814А, А9 КТ814Б, Б9 КТ814В, В9 КТ814Г, Г9	Uкэ max	В	40 50 70 100
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	5
Постоянный ток коллектора	Iк max	А	1,5
Импульсный ток коллектора	Iки max	А	3
Максимально допустимый постоянный ток базы	Iб max	А	0,5
Рассеиваемая мощность коллектора	Pк max	Вт	10
Температура перехода	Tпер	°C	150